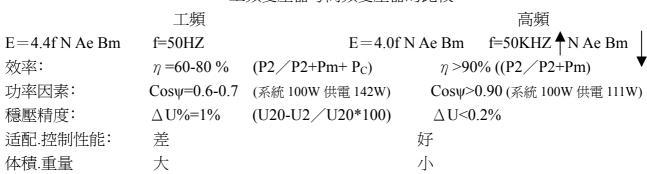
# 開關電源變壓器設計 (草稿)

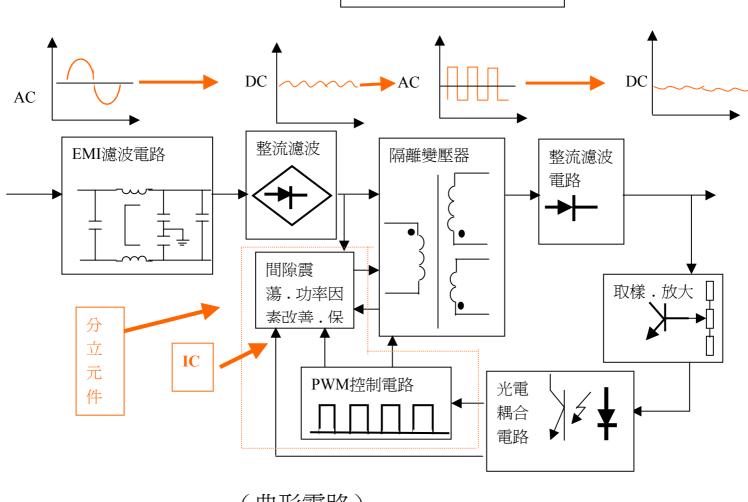
開關變壓器是將 DC 電壓,通過自激勵震蕩或者 IC 它激勵間歇震蕩形成高頻方波,通過變壓器耦合到次級,整流后達到各种所需 DC 電壓.

變壓器在電路中電磁感應的耦合作用,達到初.次級絕緣隔離,輸出實現各种高頻電壓.目的:減小變壓器体積,降低成本,使設備小形化,節約能源,提高穩壓精度.

### 工頻變壓器与高頻變壓器的比較:



# SPS 開關電源方框圖



(典形電路)

# 開關變壓器主要工作方式

一.隔离方式: 有隔离; 非隔离 (TV&TVM11)

二.激勵方式: 自激勵; 它激勵 (F+&IC)三.反饋方式: 自反饋; 它反饋 (F-&IC)

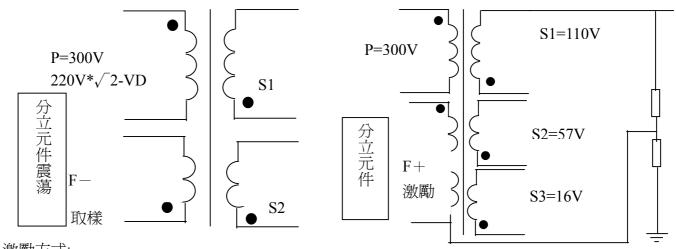
四.控制方式: PWM: PFM (T&ToN)

五.常用電路形式: FLYBACK & FORWARD

### 一.隔离方式:

有隔离:P-S 不共用地

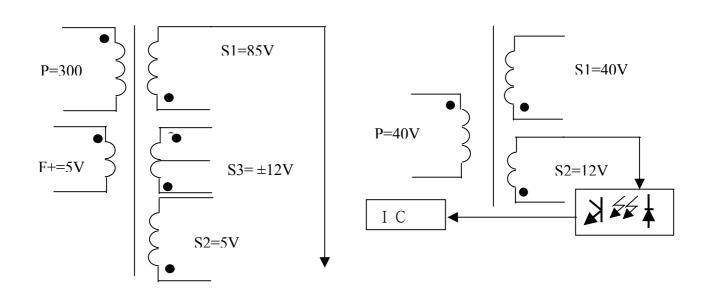
非隔离:P-S 共用地, 俗稱熱底板



二.激勵方式:

自激勵: 用變壓器 F+自激勵震蕩

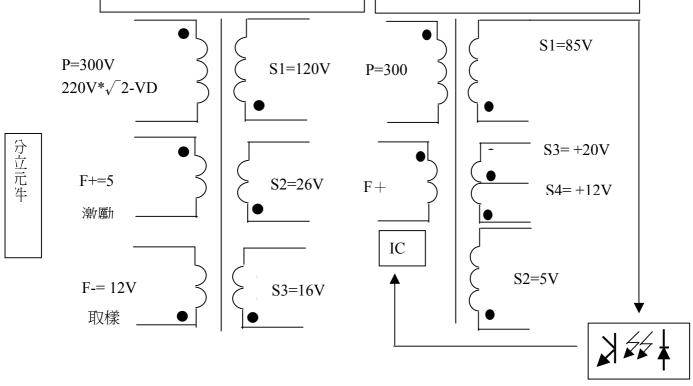
它激勵: 用集成 IC 它激勵間歇震蕩



## 三.反饋方式:

自反饋:用變壓器 F-同步于主輸出調整理 Ton,達到輸出穩定.

它反饋: 用集成 IC 接受輸出光電 耦合信號,調整 Ton,達到輸出穩定.



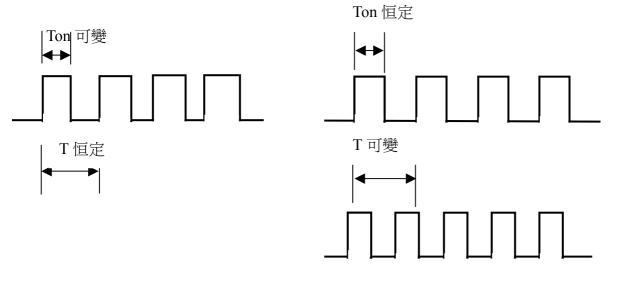
四.控制方式:

PWM:

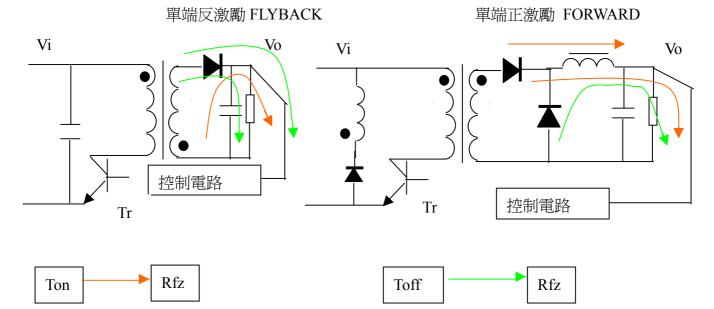
PFM

# 脈沖寬度調制

### 脈沖頻率調制



### 五.常用電路形式:



# 開關變壓器主要設計參數

靜態測試參數:

 $R_{DC.}$  L.  $L_{K.}$   $L_{DC.}$  TR. IR. HI-POT. IV<sub>O-P.</sub> Cp. Z. Q......

動態測試參數:

材料選擇參數

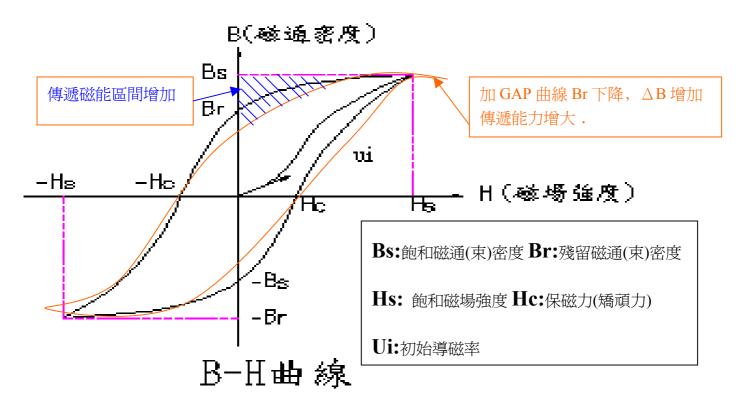
CORE: P. Pc. ui. A<sub>L.</sub> Ae. Bs......

WIRE:  $\Phi$   $\circ$  .  $\Phi$   $I_{max}$ . HI-POT......

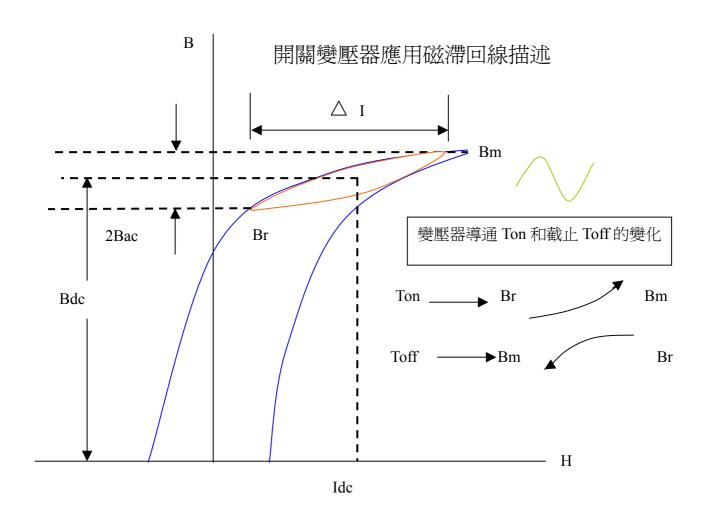
BOBBIN: UL94 V--O.( PBT. PHENOLIC. NYLON).......

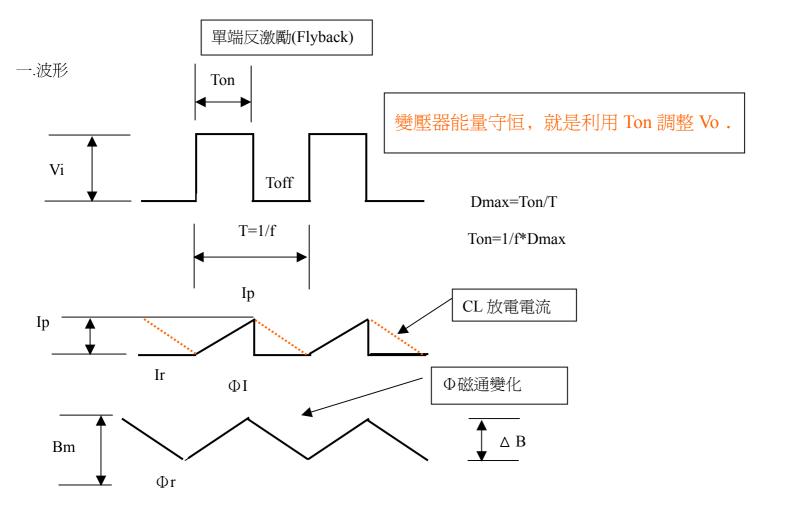
TAPE:  $^{\circ}$ C .  $\delta_{h}$ . HI-POT......

製程設置要求...



單端反激勵 FLYBACK 調節 TON 使能量守恒定  $1/2*L_P*I_{PK}^2=1/2*L_S*I_{SK}^2$ 





單端反激勵(Flyback)波形分為:臨界狀態,非連續狀態,連續狀態(常用狀態).

### 二.設計公式

$$Po=1/2LI_{pk}^{2}*f(\eta) \qquad Vi_{min}=I_{pk}*Lp/Ton$$
 
$$Po/Vi_{min} \qquad I_{pk}=2Po/D_{max}Vi_{min} \qquad (Po=VoIo)$$
 
$$Vi_{min}*Ton=I_{pk}*Lp \qquad Lp=Vi_{min}*D_{max} / I_{pk}*f$$
 
$$Np=Lp*I_{pk} / Ae* \Delta B \qquad Np= \Delta B*Ig/ 0.4 \pi *I_{pk}$$
 
$$Ig=0.4 \pi L_{p}I_{pk}^{2} / Ae* \Delta B^{2}$$
 
$$Vo+VD=Vimin*(Dmax/1-Dmax)*Ns/Np$$
 
$$Ns=(V_{O}+V_{D})*(1-Dmax)*Np/Vi_{min}*D_{max}$$
 
$$Core=g/w(f=20k_{Hz}REF)$$

Dmin=Dmax/(1-Dmax)K+Dmax K=Vi<sub>max</sub>/Vimin

# 單端反激勵(Flyback)設計例題一

```
條件:
```

V<sub>i</sub> =170V-270V , f= 30K<sub>HZ</sub> Vo= 5V, Io=20A, D<sub>max</sub>=0.45(設計取値) 設計:

1) Vi min=170\*1.4--20=218V, Vi max = 270\*1.4 - 20 = 358V $\underline{\text{Vi}} \text{ min}=170*\sqrt{2-(\text{V}_{\text{D.}}\Delta\text{U})}$   $\underline{\text{Vi}} \text{ max}=270*\sqrt{2-(\text{V}_{\text{D.}}\Delta\text{U})}$   $\underline{\text{Vi}} \text{ min}=$  $(V_{iACMIN})^2$ - 2Po(1/2fL -tc) 2)  $I_{pk}=2*5*20/218*0.45=2.04A$ ηCIN

 $P_0=1/2LI_{nk}^2*f(\eta)$ Ipk=2Po / DmaxVimin (Po=VoIo)

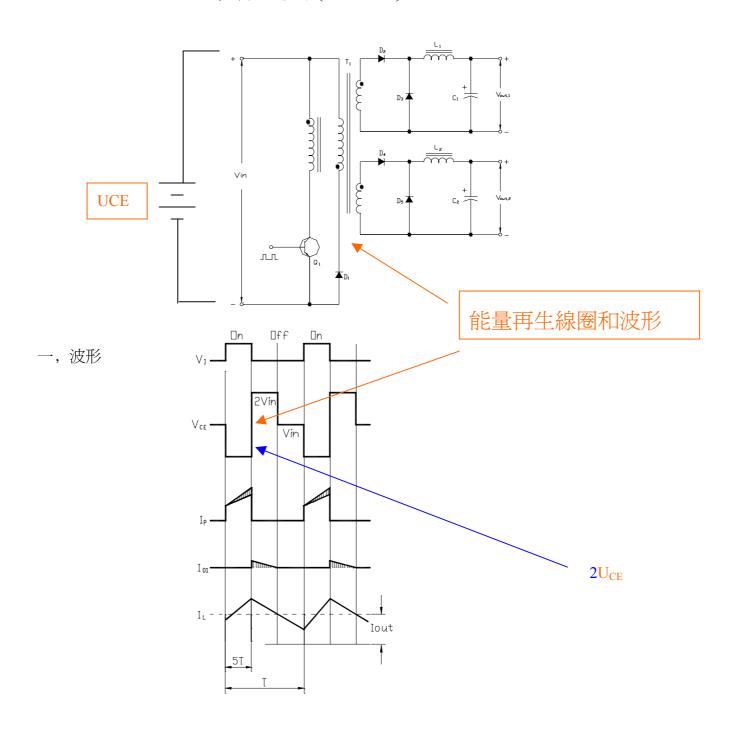
- 3) Lp=218\*0.45/2.04\*30000=1.6mHLp=Vimin\*Dmax / Ipk\*f
- 4) K=358/218=1.64
  - K=Vimax/Vimin
- 5) Dmin=0.45/(1-0.45)\*1.64+0.45=0.332 Dmin=Dmax/(1-Dmax)K+Dmax
- 6) CORE 杏表 100W 選擇 EER42/15 Ae=183mm<sup>2</sup>(1.83cm<sup>2</sup>) Bs=390mT(3900Gs)  $Core=g/w(f=20k_{Hz}REF)$
- 7) WIRE 查表 或  $\$\Phi = \sqrt{1/3} = \sqrt{20/3} = 2.58$ mm 選"銅箔"爲佳. $P\Phi = \sqrt{2.04/3} = 0.82$ , 選 0.60X2 $r^{2*}\pi$  (2.58/2)<sup>2\*3</sup>.14=5.225 選擇 19#,  $\Phi$ =0.98\*7 (0.98/2)<sup>2</sup>\*3.14\*7=5.277 (4Pin 並繞)
- 8)  $Ig=(0.4*3.14*1.6*10^{-3}*2.04^2/1.83*1950^2)*10^8=0.12cm$ Ig=0.4  $\pi$  LpIpk<sup>2</sup>/Ae\*  $\Delta$  B<sup>2</sup>
- 9) Np=1950\*0.12 \( \times 0.4\*3.14\*2.04=91.32T \)  $Np = \Delta B*Ig / 0.4 \pi*Ipk$
- 10) Ns=(5+1)\*(1-0.45)\*91/218\*0.45=3.06T 11) P= $1/2*1.6*2.04^2*30=96W$  $Ns=(V_O+V_D)*(1-Dmax)*Np/Vimin*Dmax$

 $Np=(0.0016*2.04/1.83*1950)*10^8=91.46T$  $Np=Lp*Ipk /Ae*\Delta B$ 

 $P=1/2IJ^{2}*f$ 

另一种AP法,計算參數查找麻煩

# 單端正激勵(Forward)



# 二,設計公式:

### 單端正激勵(FORWARD)設計例題一

### 已知條件:

輸入電壓 . Vi= 48V (36~60V), 額定輸出電壓.電流. Vo=5.0V. Io=11A

額定輸出功率 55W. 最大輸出功率 65W

f=470kHz (450~500 kHz)  $\delta$  max=0.42  $\eta$ =82

設計步驟: 選擇 PC50. 3F3. N49 等材質

選 PC50. EPC25. Ae: 46.4mm<sup>2</sup>. Le: 59.2mm. Bs: 3800Gs

1): Ipk= Ic= 2POUT / Vinmin= 2\*65 / 36= 3.6A

2): Np= Vinmax\*10<sup>8</sup> / (4FBmax\*Ae) 取 Bmax=2000G

= 60\*10<sup>8</sup> / (4\*450K\*2000G\*0.464)= 4TS, 調整為 6TS

3): Ns= Np \*(Vo+V<sub>D</sub>) / (Vi\* $\delta$ max)

= 4\* (5.5+1)/(36\*0.42)= 1.7TS 調整爲 2TS

4): 反饋繞組. N= Np\*(15+1) / (36\*0.42)= 6\*16/(36\*0.42)= 6TS

5): 選擇繞組線徑 Np: Φ0.1\*120C

Ns: Φ0.1\*200C

N: Φ0.25

6): 由於爲安全電壓.故不須包 MARGIN TAPE.

### 單端正激勵(FORWARD)設計例題二

### 已知條件:

輸入電壓 . Vi= 100V (85V~135V),

額定輸出電壓.電流. Vo=5.0V(4.5-5.5). Io=20A

f=200kHz  $\delta$  max=0.42

設計步驟: 選擇 PC40..TP4 等材質

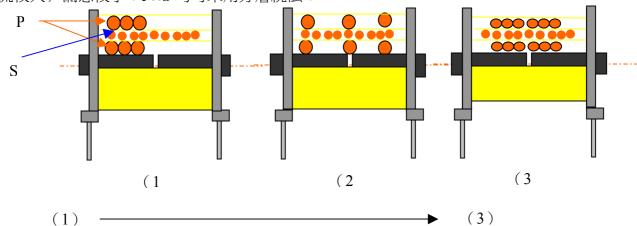
選 TP4, EE28C. Ae: 87.4mm<sup>2</sup>. Bs: 3800Gs 取 Bmax=2000G

- 1): T=1/fo=1/200K=5us
- 2): Tonmax=T\*Dmax=5\*0.42=2.1us
- 3): V2min=(Vo+VL+VF)\*T/Tonmax=(5.5+0.2+0.5)\*5/2.1=14.8V
- 4): **n**=V2min/V1min=14.8/100=0.148
- 5):  $N2=(V2min*Tonmax/Bs*Ae)*10^4 = (14.8*2.1/2000*87.4)*10^4 = 1.83T \le 2T$
- 6):  $N1 = N2/ n = 2/0.148 = 13.5T \le 14T$

Tonmax=(Vo+VL+VF)\*T/ V2min=2.09 Dmax= Tonmax/T=2.09/5=0.418\(\infty\)0.42

### 优化設計舉例

1) 繞線空間設計: 變壓器繞線空間設計得好, 使其耦合傳遞最佳, 發揮功率更佳, 干扰更小, 要求電流較大, 漏感較小. P&S 均可采用分層繞法.



### 例一, ETD44 AV 音響主功率變壓器

(1) — (3)

例二, EI22 DVD 輔助變壓器

(2)			(3)		
例三,EI	ER28 DVI	D主功率變壓器			
			34	Φ 0.40	25T
34	Φ 0.40	25T	1715	$\Phi$ 0.40X5	4T
1715	Ф0.40X2	4T	42	Φ 0.40	25T
42	Φ 0.40	25T	1413		
1413			21	Φ 0.40	25T
21	Ф 0.40	25T			

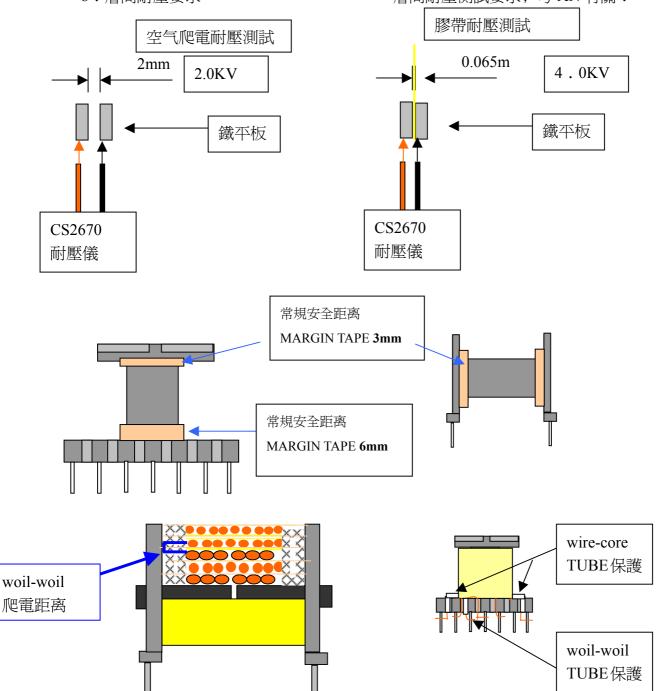
### 2) 絕緣空間設計

隨著變壓器的小形化,可以根据爬電距离來實現安全性能要求,設計產品的 目的,主要滿足用戶要求,符合安全性能規定.

1. 干燥空气爬電耐壓距离:

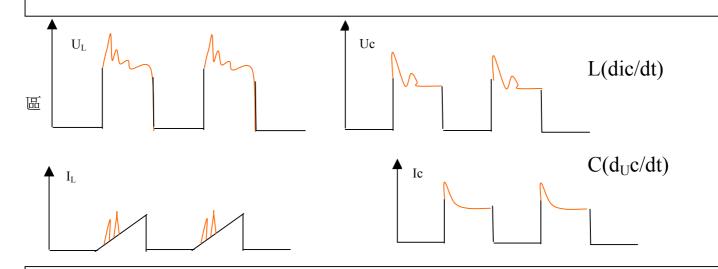
- 經驗距离爲 1mm /1000V.
- 2. TAPE (0.025/0.065) P-S 三層規定: 1層>4000V 延伸變形后>1500V.
- 3.S線圈-S線圈之間爬電耐壓距离:
- > 1500 V > 1.5 mm.
- 5.采用TEX-E線解決耐壓距离:
- 6. 膠帶絕緣層解決耐壓距离:
- 7. 規格耐壓條件(3.0KV/60'2mA)
- 8. 層間耐壓要求:

4. 邊緣膠帶 MARGINTAPE 爬電耐壓距离: 邊緣安膠 W=3mm 可根据 Vi 電壓 W1.5-2.mm. 三重絕緣線 層>6000V 延伸變形后耐壓下降. 膠帶村墊 SOL 一層 SPC 二層, 反貼膠帶等. 制程條件 UL3.0KV \*1.2 倍/2'2mA. 層間耐壓測試要求, 与 AN 有關.



# 3) 開關變壓器的參數分析

一,漏感  $L_k$ : 當開關管達到高速開關時,(截止)由于變壓器的  $L_k$  存在,開關管兩端就會產生浪涌電壓.整机中可以采用(電壓鉗位電路)來控制.



二,分布電容 Cp: 當開關管 (導通)由于開關寄生電容及變壓器 Cp 產生浪涌電流,流向開關產生很大噪聲 . 整机中可以采用(電流限制電路)來控制.

三,集膚效應: 線圈中流過高頻電流時在開關頻率較高,電流只在導線的表皮流過,稱為集膚效應,高速開關下磁力線引起渦流,抵消中心電流,導線形成空心導体.

穿透深度  $\Delta=6.61/\sqrt{f(mm)}$  高頻 >100KHZ,線經不超過穿透深度  $\Delta$  的兩倍爲好.例. $\Delta=0.09$  0.09 \* 2=0.18 選用 0.10 -0.17

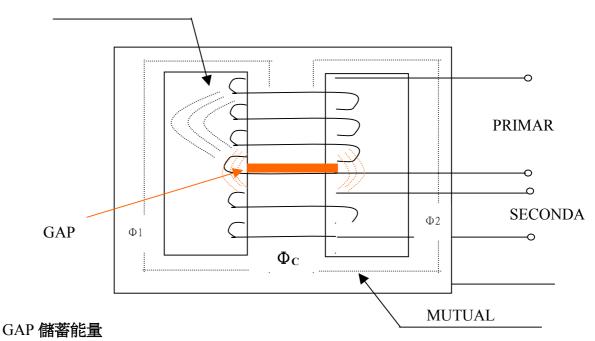


1.關于集膚效應可選用多股線(滿足 b>a  $a=r^2\pi$   $b=r^2\pi*x$  x=x 股線)滿足高頻負載電流,降低變壓器溫升.

2. 關于  $L_k$  与 Cp 是一對矛盾,一般要求變壓器平衡  $L_k$  与 Cp 參數, $L_k$  不要追求愈小愈好,Cp 的增加會引起噪聲的增加.

# 開關變壓器 GAP&LK

### **LEAKAGE**



# $1/2 L I^2 = \triangle_B * \triangle_B /u_0 0.4 \pi * Ae Ig$ 儲能 磁感 磁場 體積

### GAP 氣隙長度

Ig=0.4 
$$\pi$$
 L I  $^2$  / Ae \*  $\triangle$  B

- 1. 氣隙 GAP 設計大小与所需要的傳遞能量有關, GAP 大氣隙長度增加也就是氣隙體積增加, 電感下降. GAP 小容易引起電感飽和.
  - 2. 氣隙 GAP 傳遞能量大小与使用的工作頻率有關,高頻時(>60KHZ) 磁芯損耗加大.
- 3.LEAKAGE 漏感:初級繞組 P&S 次級主繞組相鄰緊密,耦合面積大,(P.S 夾繞)漏感量小.S 次級主繞組如果匝數少,疏繞或者增加匝數,也可減小漏感量.